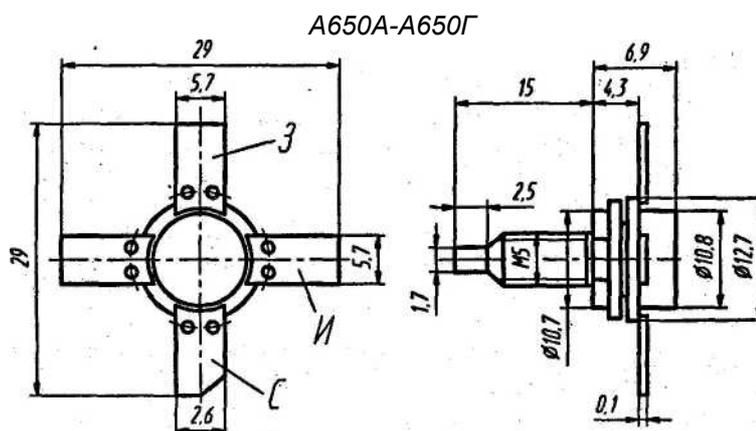


A650A, A650Б, A650B, A650Г

Транзисторы кремниевые полевые эпитаксиально-планарные с изолированным затвором и индуцированным каналом n-типа генераторные. Предназначены для применения в усилителях мощности и генераторах с рабочей частотой до 400 МГц в непрерывном и импульсном режимах при напряжении питания 40 В, а также в переключающих устройствах. Выпускаются в металлокерамическом корпусе с полосковыми выводами. Тип прибора указывается на корпусе.

Масса транзистора не более 6 г.

Изготовитель — завод «Пульсар», г. Москва.



Электрические параметры

Выходная мощность в режиме класса В при $U_{CM} = 40$ В, на $f = 400$ МГц, не менее:

A650A, $I_c = 6,5$ А 50 Вт

A650Б, $I_c = 4$ А 30 Вт

A650B, $I_c = 5$ А 30 Вт

Крутизна характеристики при $U_{CM} = 20$ В,

$I_c = 0,9$ А, не менее 330 мА/В

Начальный ток стока при $U_{CM} = 20$ В, $U_{31Л} = 0$, не более:

A650A, A650Б, A650B 200 мА

A650Г 30 мА

Остаточный ток стока, при $U_{CM} = 50$ В, $U_{31Л} = 0$ В, не более:

A650A, A650Б, A650B 100 мА

A650Г 30 мА

Ток стока при $U_{cu} = 20$ В, $U_m = 20$ В, не менее:

A650A 6,5 А

A650Б 4 А

A650B, A650Г 5 А

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение сток—исток 50 В

Напряжение сток—исток в динамическом режиме 75 В

Постоянное напряжение затвор—исток 25 В

Постоянное напряжение затвор—сток 60 В

Потенциал статического электричества 50 В

Постоянная рассеиваемая мощность¹:

при $T_k = -60...+40$ °С:

A650A, A650Б 60 Вт

A650B, A650Г 40 Вт

при $T_k = +125$ °С:

A650A, A650Б 14 Вт

A650B, A650Г 10 Вт

Температура окружающей среды $-60... T_k = +125$ °С

¹ При $T_k > +40$ °С максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность снижается линейно.

Крепление транзистора к панели следует осуществлять при помощи гайки, при этом корпус транзистора должен плотно прилегать к теплоотводу с шероховатостью поверхности не более 0,8 мкм и неплоскостью не более 0,02 мм. Крутящий момент на монтажный винт при креплении 0,18 кгс • м.

В условиях морского и тропического климата транзисторы необходимо использовать в составе герметизированной аппаратуры или при местной защите транзистора от воздействия окружающей среды с целью сохранения I_3 ут на уровне 10^{-7} А.

Конструкция транзистора А650В обеспечивает отпайку фланца от корпуса и не менее, чем трехкратную перепайку транзистора на монтажную поверхность гибридных схем. Температура пайки не выше $+200$ °С, время пайки не более 8 с. Для отпайки фланца от корпуса проводят локальный подогрев винта фланца.

Допускается обрезать полосковые выводы на расстоянии 4 мм от корпуса с сохранением среза на стоковом выводе.